

手性障碍电磁散射的 PML 有限元计算 *

¹ 高天玲 ² 马富明

(¹ 深圳大学数学与计算科学院 广东深圳 518060; ² 吉林大学数学学院 长春 130021)

摘要: 该文建立了手性障碍电磁散射问题的二维模型, 给出问题的有限元分析, 并利用结合 PML(perfectly matched layers) 技术的有限元法进行数值模拟.

关键词: 手性; PML; 有限元法.

MR(2000) 主题分类: 65N06 **中图分类号:** O242.21 **文献标识码:** A

文章编号: 1003-3998(2009)03-643-08

1 问题模型

在各向同性手性介质中, 电磁场遵循 Maxwell 方程组

$$\nabla \times \mathbf{E} - \frac{ik}{\mu} \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{H} + \frac{ik}{\varepsilon} \mathbf{D} = 0, \quad (1)$$

以及 Drude-Born-Fedorov (DBF) 本构方程 [1]

$$\mathbf{D} = \varepsilon(\mathbf{E} + \beta \nabla \times \mathbf{E}), \quad \mathbf{B} = \mu(\mathbf{H} + \beta \nabla \times \mathbf{H}), \quad (2)$$

其中 $\mathbf{E}, \mathbf{H}, \mathbf{D}$ 和 \mathbf{B} 分别表示电场、磁场、电位移和磁感应强度, ε 和 μ 分别是手性介质的介电系数和磁导率, $k = \omega \sqrt{\varepsilon \mu}$ 为波数, β 是手性导纳 (chirality admittance), 它在一定程度上可以反映手性介质的旋光性强度.

结合 (1) 和 (2) 式有在手性介质中 E, H 满足

$$\nabla \times \mathbf{E} = \gamma^2 \beta \mathbf{E} + i \frac{\gamma^2}{k} \mathbf{H}, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \gamma^2 \beta \mathbf{H} - i \frac{\gamma^2}{k} \mathbf{E}, \quad (3)$$

其中 $k = \omega \sqrt{\varepsilon \mu}$, $\gamma^2 = \frac{k^2}{1-(k\beta)^2}$. 始终假设 $k\beta < 1$.

下面建立有界手性障碍电磁散射问题的模型. 如图 1, 假设有界手性障碍是一个平行于 x_3 方向的柱体 $\tilde{D} = \{x \in \mathbb{R}^3 | (x_1, x_2) \in D, x_3 \in \mathbb{R}\}$. D 是柱体 \tilde{D} 在 x_1-x_2 平面的截面, 是单连通的, 其边界 ∂D 是 $C^{2,\alpha}$ 的. \tilde{D} 内是手性导纳为 β 的手性介质. \tilde{D} 周围是介电常数 ε , 磁导率是 μ 的介质, 距离 \tilde{D} 充分远处为真空. 考虑以平面波形式入射的电磁场入射到有界手性介质障碍 \tilde{D} 的电磁散射情况.

收稿日期: 2007-10-30; 修订日期: 2009-03-30

E-mail: tlgaoszu.edu.cn

* 基金项目: 深圳大学校级基金 (200855) 和国家自然科学基金 (10726050, 10801063) 资助

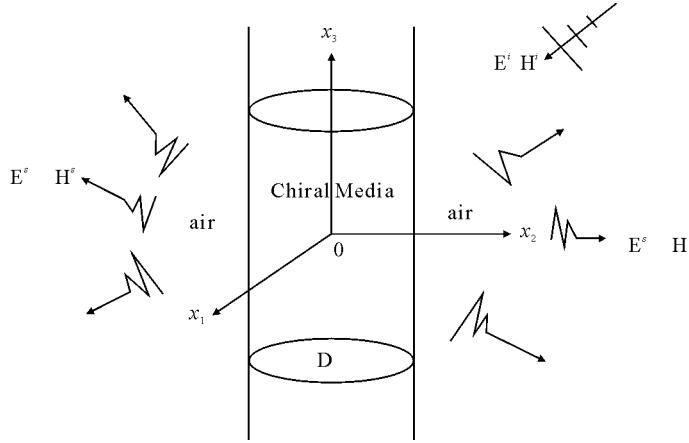


图 1 有界手性介质障碍电磁散射

假设所有的参数与 x_3 分量无关, 电磁场 \mathbf{E}, \mathbf{H} 各个分量也都与 x_3 无关. 令 $\mathbf{E} = (e_1, e_2, e_3)^T, \mathbf{H} = (h_1, h_2, h_3)^T$. 代入 (3) 式, 有

$$\nabla \cdot \left(\frac{1}{k} \nabla e_3 \right) - i \nabla \cdot (\beta \nabla h_3) = -i\gamma^2 \beta h_3 - \frac{\gamma^2}{k} e_3, \quad (4)$$

$$\nabla \cdot \left(\frac{1}{k} \nabla h_3 \right) + i \nabla \cdot (\beta \nabla e_3) = i\gamma^2 \beta e_3 - \frac{\gamma^2}{k} h_3. \quad (5)$$

记 e^i, h^i 为入射场 $\mathbf{E}^i, \mathbf{H}^i$ 在 x_3 方向的分量, e^s, h^s 为散射场 $\mathbf{E}^s, \mathbf{H}^s$ 在 x_3 方向的分量. $e^s = e_3 - e^i, h^s = h_3 - h^i$, 这样得到 \mathbb{R}^2 中关于 e^s 和 h^s 的微分方程

$$\nabla \cdot \left(\frac{1}{k} \nabla e^s \right) - i \nabla \cdot (\beta \nabla h^s) + i\gamma^2 \beta h^s + \frac{\gamma^2}{k} e^s = -f_1, \quad (6)$$

$$\nabla \cdot \left(\frac{1}{k} \nabla h^s \right) + i \nabla \cdot (\beta \nabla e^s) - i\gamma^2 \beta e^s + \frac{\gamma^2}{k} h^s = -f_2, \quad (7)$$

这里 f_1 和 f_2 如下

$$f_1 = \nabla \cdot \left(\frac{1}{k} \nabla e^i \right) - i \nabla \cdot (\beta \nabla h^i) + i\gamma^2 \beta h^i + \frac{\gamma^2}{k} e^i,$$

$$f_2 = \nabla \cdot \left(\frac{1}{k} \nabla h^i \right) + i \nabla \cdot (\beta \nabla e^i) - i\gamma^2 \beta e^i + \frac{\gamma^2}{k} h^i.$$

引入关于 e^s, h^s 的新向量 $\mathbf{u}^s = (e^s, h^s)^T$, 并定义符号 $\nabla \mathbf{u}^s = (\nabla e^s, \nabla h^s)^T$, 则 (6)、(7) 式可表达为如下向量形式的微分方程

$$\nabla \cdot (A_1 \nabla \mathbf{u}^s) + B_1 \mathbf{u}^s + \mathbf{f} = 0, \quad x \in \mathbb{R}^2, \quad (8)$$

其中

$$A_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{k} & -i\beta \\ i\beta & \frac{1}{k} \end{pmatrix}, \quad B_1 = \begin{pmatrix} \frac{\gamma^2}{k} & i\gamma^2 \beta \\ -i\gamma^2 \beta & \frac{\gamma^2}{k} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{f} = (f_1, f_2)^T. \quad (9)$$

另外要求散射场 \mathbf{u}^s 在各个方向还一致地满足辐射条件

$$\lim_{r \rightarrow \infty} \sqrt{r} \left(\frac{\partial \mathbf{u}^s}{\partial \eta} - ik \mathbf{u}^s \right) = 0, \quad (10)$$

其中 $\eta = x/|x|$, $r = |x|$.

通过以上的表述, 有界手性障碍电磁散射问题可叙述为: 以平面波形式传播的入射电磁场 $\mathbf{u}^i = (e^i, h^i)^T$, 入射到有界手性介质障碍 D 上, 求 $\mathbf{u}^s = (e^s, h^s)^T$, 满足 (8) 式以及辐射条件 (10).

2 问题的有限元分析

为了给出问题的变分形式, 将 \mathbb{R}^2 的问题转化为有界区域 B_R (假设 B_R 是一个以圆点为心半径为 R , 包含 D 的充分大的圆) 的问题, 先讨论在 ∂B_R (∂B_R 为 B_R 的边界) 上 \mathbf{u}^s 满足的条件. 以下总假设 R 充分大, $\mathbb{R}^2 \setminus B_R$ 外是介电常数为 ε_0 , 磁导率为 μ_0 的真空.

在 $\mathbb{R}^2 \setminus B_R$ 上, $\beta = 0$, 散射场 e^s 和 h^s 满足 Helmholtz 方程

$$(\Delta + k_0^2) \mathbf{u}^s = 0, \quad (11)$$

这里 $k_0 = \omega \sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}$.

注意到当 $r = |x| > R$ 时, Helmholtz 方程 (11) 的散射解 $\mathbf{u}^s = (e^s, h^s)^T$ 在极坐标 (r, θ) 下可表示为如下变量分离的级数形式 [2]

$$e^s(r, \theta) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n H_{|n|}^{(1)}(k_0 r) e^{in\theta}, \quad (12)$$

这里 $H_n^{(1)}$ 是第一类 n 阶 Hankel 函数 [3]. 级数 (12) 在 $r > R$ 时一致收敛.

另一方面易知 e^s 在边界 ∂B_R 上是周期函数, 因此 e^s 有如下的 Fourier 级数展开

$$e^s(R, \theta) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{(n)}(R) e^{in\theta}, \quad (13)$$

其中

$$e^{(n)}(R) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^s(R, \theta) e^{-in\theta} d\theta.$$

由 (12) 和 (13) 式, 有

$$e^s(r, \theta) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{e^{(n)} H_{|n|}^{(1)}(k_0 r)}{H_{|n|}^{(1)}(k_0 R)} e^{in\theta}, \quad r \geq R. \quad (14)$$

记 ν 为 ∂B_R 的外法向量, 由 (14) 式可以求 e^s 在 ∂B_R 的外法方向导数

$$\frac{\partial e^s(r, \theta)}{\partial \nu} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{k_0 e^{(n)} H'_{|n|}^{(1)}(k_0 r)}{H_{|n|}^{(1)}(k_0 R)} e^{in\theta}, \quad r \geq R. \quad (15)$$

对于函数 $\varphi(r, \theta)$, 引入算子 T ,

$$T(\varphi) \triangleq \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{k_0 \varphi^{(n)} H'_{|n|}^{(1)}(k_0 r)}{H_{|n|}^{(1)}(k_0 R)} e^{in\theta}, \quad (16)$$

其中

$$\varphi^{(n)} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \varphi(r, \theta) e^{-in\theta} d\theta.$$

引理 2.1 算子 $T : H^{1/2}(\partial B_R) \rightarrow H^{-1/2}(\partial B_R)$ 如 (16) 式定义, 则问题 (8)–(10) 的解满足

$$\frac{\partial e^s(r, \theta)}{\partial \nu} = T e^s, \quad x \in \partial B_R, \quad (17)$$

$$\frac{\partial h^s(r, \theta)}{\partial \nu} = T h^s, \quad x \in \partial B_R, \quad (18)$$

其向量形式, $T : (H^{1/2}(\partial B_R))^2 \rightarrow (H^{-1/2}(\partial B_R))^2$,

$$\frac{\partial \mathbf{u}^s(r, \theta)}{\partial \nu} = T \mathbf{u}^s, \quad x \in \partial B_R. \quad (19)$$

边界截断算子 T 的引入, 散射问题可描述为有界区域 B_R 上问题: 以平面波形式传播的入射电磁场 $\mathbf{u}^i = (e^i, h^i)^T$, 入射到有界手性介质障碍 D 上, 求 $\mathbf{u}^s \in H^1(B_R) \times H^1(B_R)$ 满足 (8) 式和边界条件 (19).

现给出有界域上散射问题 (8)、(19) 的变分形式. 令 $\mathbf{v} = (q, p)^T \in H^1(B_R) \times H^1(B_R)$. 分别用 \bar{q}, \bar{p} 乘以 (6) 和 (7) 式, 再在 B_R 上积分, 并注意到在 $R^2 \setminus D$ 上 $\beta = 0$, 利用分部积分公式可得

$$\begin{aligned} & \int_{B_R} \frac{1}{k} \nabla e^s \cdot \nabla \bar{q} dx - i \int_{B_R} \beta \nabla h^s \cdot \nabla \bar{q} dx - i \int_{B_R} \gamma^2 \beta h^s \bar{q} dx \\ & - \int_{B_R} \frac{\gamma^2}{k} e^s \bar{q} dx - \int_{\partial B_R} \frac{1}{k_0} \frac{\partial e^s}{\partial \nu} \bar{q} ds(x) = \int_{B_R} f_1 \bar{q} dx. \end{aligned} \quad (20)$$

$$\begin{aligned} & \int_{B_R} \frac{1}{k} \nabla h^s \cdot \nabla \bar{p} dx + i \int_{B_R} \beta \nabla e^s \cdot \nabla \bar{p} dx + i \int_{B_R} \gamma^2 \beta e^s \bar{p} dx \\ & - \int_{B_R} \frac{\gamma^2}{k} h^s \bar{p} dx - \int_{\partial B_R} \frac{1}{k_0} \frac{\partial h^s}{\partial \nu} \bar{p} ds(x) = \int_{B_R} f_2 \bar{p} dx, \end{aligned} \quad (21)$$

则问题的变分形式为: 求 $\mathbf{w} = (e^s, h^s)^T \in H^1(B_R) \times H^1(B_R)$, 使得

$$W(\mathbf{w}, \mathbf{v}) = (\mathbf{f}, \mathbf{v}), \quad \forall \mathbf{v} = (q, p)^T \in H^1(B_R) \times H^1(B_R). \quad (22)$$

这里 $W(\mathbf{w}, \mathbf{v})$ 为 (20) 和 (21) 式左端的和, 并且 $(\mathbf{f}, \mathbf{v}) = \int_{B_R} f_1 \bar{q} dx + \int_{B_R} f_2 \bar{p} dx$.

定理 2.2 对于所有 k , 手性障碍电磁散射问题的变分问题 (22) 有唯一解

$$\mathbf{u}^s \in H^1(B_R) \times H^1(B_R).$$

设 $\{S_h; h \in (0, 1]\}$ 表示 $H^1(B_R) \times H^1(B_R)$ 的有限元子空间族, 其中 h 代表将 B_R 三角剖分后单元的最大直径. 进一步, 假设, 对任意的 $\mathbf{v} \in H^1(B_R) \times H^1(B_R)$, 有

$$\lim_{h \rightarrow 0} \inf_{\mathbf{v}_h \in S_h} \|\mathbf{v} - \mathbf{v}_h\|_1 = 0. \quad (23)$$

为了记号的方便, 用 $\|\cdot\|_l$ 来表示范数 $\|\cdot\|_{H^l \times H^l}$.

定义 (8) 的解 $\mathbf{u}^s = (e^s, h^s)^T$ 的有限元逼近 $\mathbf{u}_h = (e_h, h_h)^T \in S_h$,

$$W(\mathbf{u}_h, \mathbf{v}_h) = (\mathbf{f}, \mathbf{v}_h), \quad \forall \mathbf{v}_h = (p_h, q_h) \in S_h. \quad (24)$$

定理 2.3 假设对任意的 $\mathbf{f} \in (H^1(B_R) \times H^1(B_R))'$, (8) 和 (19) 式有唯一解 $\mathbf{u}^s \in H^1(B_R) \times H^1(B_R)$. 则对任意给定的 $\epsilon > 0$, 存在一个 $h_0 = h_0(\epsilon)$, 使得对 $0 < h < h_0$, 问题 (8) 和 (19) 的有限元解 \mathbf{u}_h 唯一存在, 且有估计

$$\|\mathbf{u}^s - \mathbf{u}_h\|_0 \leq \epsilon \|\mathbf{u}^s - \mathbf{u}_h\|_1. \quad (25)$$

此外, 如果 $\mathbf{f} \in L^2(B_R) \times L^2(B_R)$, 则存在一个 $h_1 = h_1(\epsilon)$, 使得对 $0 < h < h_1$, 有

$$\|\mathbf{u}^s - \mathbf{u}_h\|_1 \leq \epsilon \|\mathbf{f}\|_0. \quad (26)$$

定理 2.2 和定理 2.3 的证明见文献 [4].

由定理 2.3 注意到

- (i) 由于 h_0, h_1 与 \mathbf{u}^s 无关, 从而估计关于 \mathbf{u}^s 是一致的.
- (ii) 如果手性材料的各项参数是光滑函数, 并且当界面 ∂D 是 $C^{1,1}$ 时, 则由经典椭圆估计知, 解 \mathbf{u}^s 的正则性可以提高, 比如由经典的有限元理论, 可得到比定理 2.3 更好的误差估计和收敛性结果. 然而, 由于实际应用中经常是分段光滑, 并且很多物理参数是分片常数, 故在通常情况下我们只能得到定理 2.3 的结果.

3 数值实验问题模型

在实际数值计算中, 由于边界算子 T 无穷级数的引入, 直接用有限元来实现较为困难, 我们通过结合 PML 技术^[5] 的有限元法对有界手性介质电磁散射问题进行数值计算.

例 1 入射场为平面波 $e^i = e^{ik \sin(\theta)x_1 - ik \cos(\theta)x_2}$, $h^i = 0$, 取入射角度 $\theta = \pi/6$, 入射到障碍物 D 上. 介电常数 ε 和磁导率 μ 如下

$$\varepsilon(x) = \begin{cases} 1.96, & x \in \bar{D}, \\ 1, & x \in \mathbb{R}^2 \setminus D, \end{cases} \quad \mu(x) = \begin{cases} 1, & x \in \bar{D}, \\ 2, & x \in \mathbb{R}^2 \setminus D. \end{cases} \quad (27)$$

数值试验中分以下两种情况

- (I) D 为手性导纳 $\beta = 0.5$ 的手性介质障碍.
- (II) D 是非手性的, 即 $\beta = 0$, 其他的参数取法不变. 也就是在 TM 情况下一般的介质问题.

设置 PML 如图 2 所示, 在 B_R 外为 PML 层 $\Omega^{\text{PML}} = \{x \in \mathbb{R}^2 : R < |x| < \rho\}$. 实际计算中的误差有两部分组成, 一部分是加 PML 层所引起的 PML 解与真解的误差, 另一部分就是进行有限元计算剖分所带来的误差.

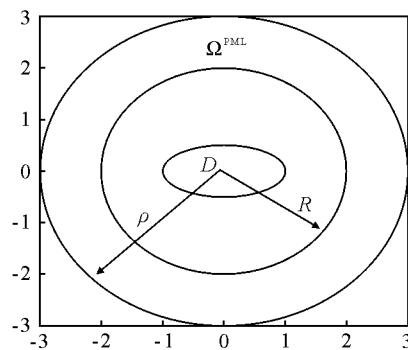


图 2 手性介质 D 形状以及计算区域

具体算法如下

1) 限制 PML 解与真解的误差, 来确定 PML 中的 σ, ρ . 通常取 $\sigma = \sigma_0 \left(\frac{r-R}{\rho-R} \right)^m$, 其中常数 $\sigma_0 > 0$, 整数 $m \geq 1$.

在数值试验中取 $m = 2, R = 2$, 限制

$$e^{-k} \operatorname{Im}(\tilde{\rho}) (1 - \frac{R^2}{|\tilde{\rho}|^2})^{1/2} \leq 10^{-9},$$

由此确定 $\rho = 3$, 故 PML 厚度 $\delta = \rho - R = 1$.

2) 在计算区域上 $\Omega^\rho = B_R \cup \Omega^{\text{PML}}$ 上剖分, 利用 Matlab 进行有限元计算.

图 3 和图 4 分别给出了 (I)、(II) 条件下 B_R 中电场和磁场的实部. 图 5 和图 6 分别给出在 (I)、(II) 条件下电场磁场在边界 ∂B_R 上振幅的比较.

由此例看出, 在情况 (I) 下入射磁场为零, 通过手性介质 D 后, 入射场的振动面发生变化, 产生了磁场, 见图 3. 而在情况 (II) 下, D 内非手性时, 没有入射磁场时, 通过 D 的散射场也没有磁场产生, 见图 4.

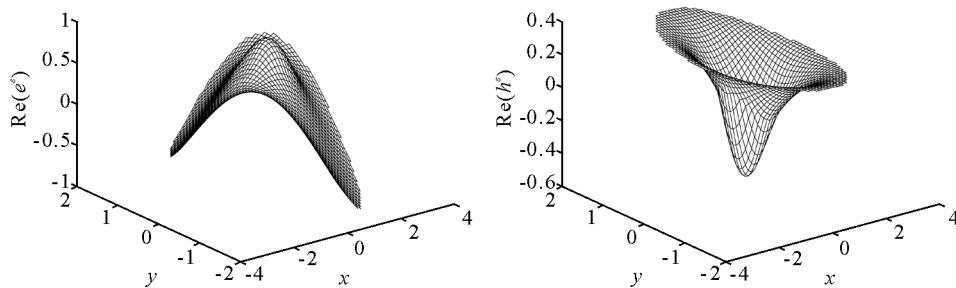


图 3 (I) 条件下 B_R 中电磁场 e^s, h^s 的实部

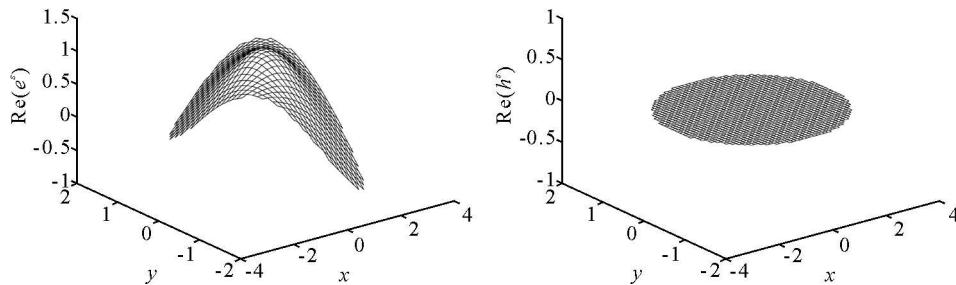


图 4 (II) 条件下 B_R 中电磁场 e^s, h^s 的实部

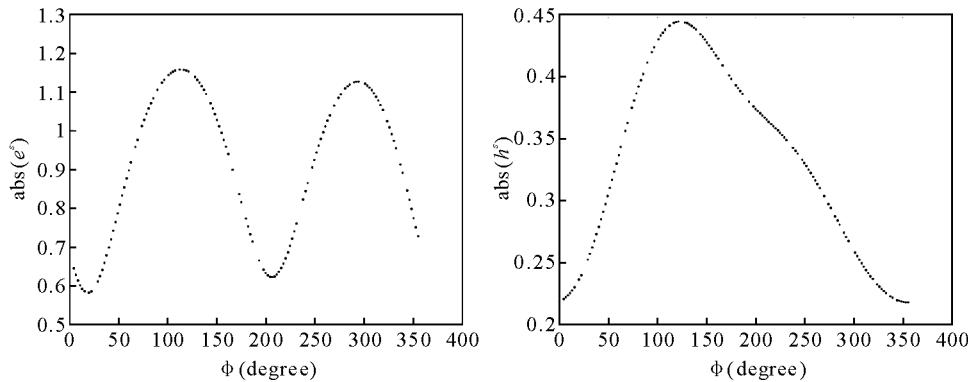
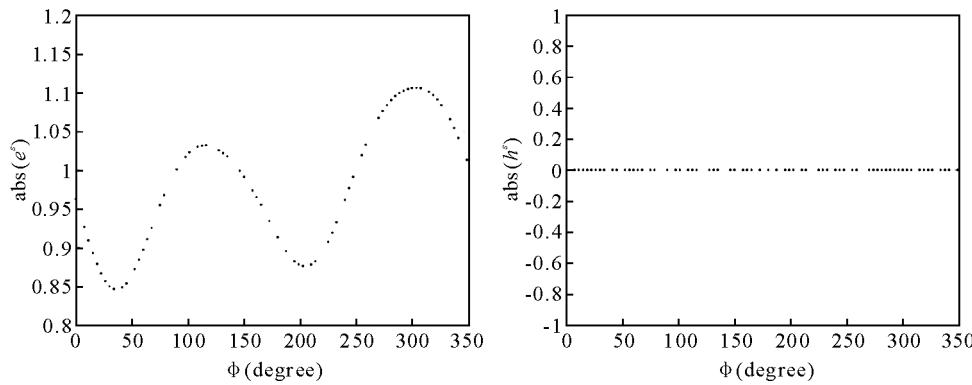


图 5 (I) 条件下 B_R 中电磁场 e^s, h^s 的振幅

图 6 (II) 条件下 B_R 中电磁场 e^s, h^s 的振幅

这也表明了手性介质的性质: 使通过它的偏振光的振动面发生变化, 即表现出旋光性(optical activity).

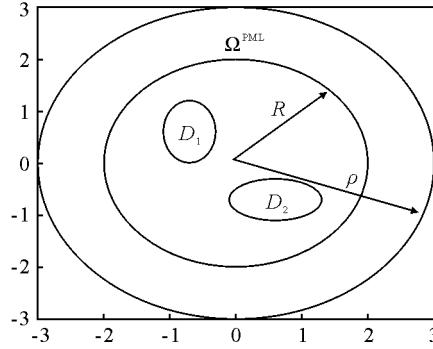
例 2 如图 7 手性介质 D 不为单连通的情况. 其他参数不变. 入射场以平面波 $e^i = e^{ik \sin(\theta)x_1 - ik \cos(\theta)x_2}$, $h^i = 0$ 形式入射, 以 $\theta = \pi/6$ 角度入射到手性介质障碍 $D = D_1 \cup D_2$ 上. D 的手性导纳为

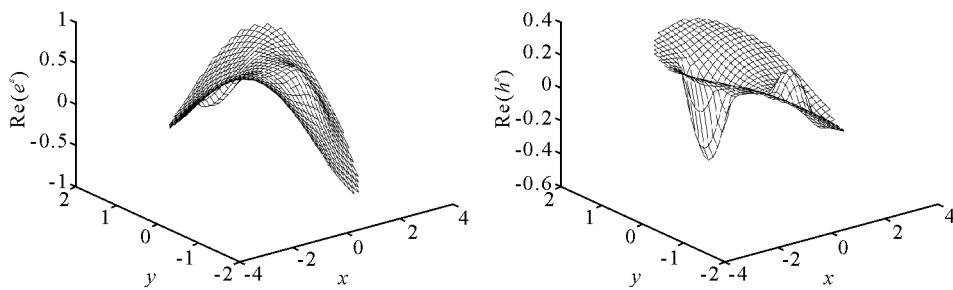
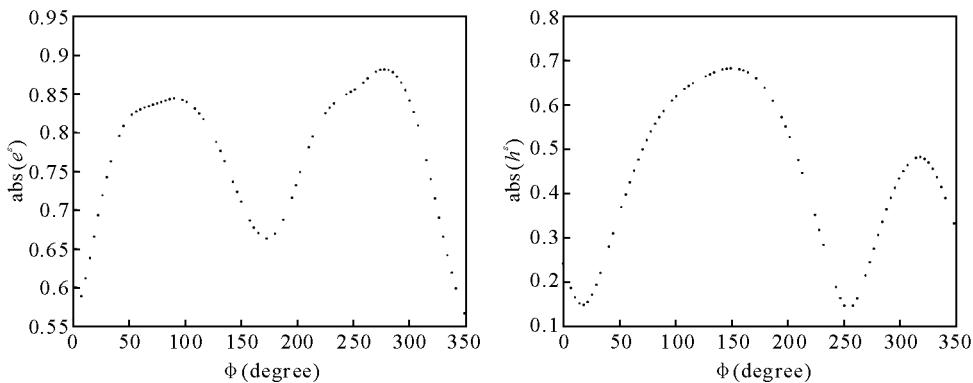
$$\beta = \begin{cases} 0.5, & x \in D_1, \\ 0.2, & x \in D_2, \end{cases} \quad (28)$$

介电常数 ε 和磁导率 μ 如下

$$\varepsilon = \begin{cases} 1.96, & x \in \bar{D}, \\ 1, & x \in \mathbb{R}^2 \setminus D, \end{cases} \quad \mu = \begin{cases} 1, & x \in \bar{D}, \\ 2, & x \in \mathbb{R}^2 \setminus D. \end{cases} \quad (29)$$

具体的算法以及 PML 的设置同例 1, 图 8 给出 B_R 上电场磁场的实部, 图 9 给出 ∂B_R 上电场磁场的振幅.

图 7 两个障碍物 D 形状以及计算区域

图 8 B_R 中电磁场 e^s, h^s 的实部图 9 ∂B_R 上电场 e^s, h^s 的振幅

参 考 文 献

- [1] Athanasiadis C, Costakis G, Stratis I G. Electromagnetic scattering by a homogeneous chiral obstacle in a chiral environment. *SIMA J Appl Math*, 2000, **64**: 245–258
- [2] Colton D, Kress R. Inverse Acoustic and Electromagnetic Scattering Theory. New York: Springer-Verlag, 1992
- [3] John F. Partial Differential Equations. Fourth Edition. New York: Springer-Verlag, 1982
- [4] 高天玲. 某些手性介质电磁散射和反散射数学问题的分析与计算. 长春: 吉林大学, 2007
- [5] Collino F, Monk P B. The perfectly matched layer in curvilinear coordinates. *SIAM J Sci Comput*, 1998, **19**: 2061–2090

The Finite Element Method with Perfectly Matched Layers for the Electromagnetic Scattering by a Chiral Obstacle

¹Gao Tianling ²Ma Fuming

(¹College of Mathematics and Computational Science, Shenzhen University, Guangdong Shenzhen 518060;

²Department of Mathematics, Jilin University, Changchun 130021)

Abstract: This paper is concerned with the electromagnetic scattering by a chiral obstacle. A two-dimensional mathematical model is established. The existence and uniqueness of the problem is discussed by a variational approach. A finite element method with perfectly matched layers(PML) is developed for solving the problem.

Key words: Chiral media; Perfectly matched layers(PML); Finite element method.

MR(2000) Subject Classification: 65N06